УДК 549.518.1 <u>ХИМИЯ</u>

К. А. КОСТАНЯН, Дж. А. ГЁДАКЯН, С. А. БАБАЯН, Л. Г. УНАНЯН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКИСИ МЕДИ С КИСЛОРОДОМ ВОЗДУХА

(Представлено академиком А. В. Новоселовой 13 II 1973)

Система Cu — О существенна для металлургии меди, техники полупроводников и фотоэлементов. Несмотря на значительное число исследований в этой области, ряд вопросов до настоящего времени остаются дискуссионными (1, 2). В частности, нет единого мнения о состоянии из-

быточного кислорода в закиси меди $(^{2-5})$.

В настоящей работе методом дериватографии (МОМ Г-425) исследовано поведение окислов меди в воздухе и сделана попытка выяснить характер высокотемпературного взаимодействия Cu_2O с кислородом. С целью исключения кинетических факторов исследования проводились в платиновых и корундовых тиглях различных размеров, при различных скоростях нагрева образцов. Наряду с продуктами взаимодействия Cu_2O с O_2 исследовались также закись меди марки ч. д. а. и синтезированная путем термического разложения окиси меди при 1050° С. Фазовый состав исходных окислов и продуктов их термообработки контролировался методом

рентгенофазового анализа (УРС-50 ИМ).

Дериватограммы исследованных образцов веществ приведены на рис. 1, условия и результаты дериватографических опытов — в табл. 1. Из них следует, что термическое разложение окиси меди в интервале 998—1083° происходит достаточно интенсивно и довольно глубоко, с образованием кристаллической закиси меди и газообразного кислорода. Почти непосредственно после разложения СиО начинается взаимодействие Си₂О с кислородом воздуха *. Оно сопровождается резким повышением веса образцов, поглощением энергии и образованием жидких продуктов реакции (последнее подтвердилось визуальными наблюдениями). При этом привес образца на единицу массы закиси меди во всех опытах воспроизводится довольно хорошо, что позволило с высокой точностью вычислить индекс кислорода в средней формуле продукта взаимодействия (табл. 1).

Взаимодействие Cu₂O с кислородом происходит в узком температурном интервале (1098—1150°). Дальнейшее повышение температуры до 1200° сопровождается уменьшением, а понижение— повышением веса образдов (в среднем 4,5±0,3·10⁻³% на 1°C), что объясняется темпера-

турной зависимостью растворимости воздуха в расплаве.

Насыщаемость, четкие температурные границы и интенсивность продесса, а также высокое постоянство состава продукта во всех опытах позволяет предположить химическое взаимодействие закиси меди с кислородом воздуха. Продуктом этого взаимодействия является расплав состава Си₅О₃ **. Верхняя температурная граница устойчивости расплава превышает 1200°, нижняя — обусловливается ее кристаллизацией и равна

** С учетом вероятности испарения расплава более надежной представляется верхняя граница индекса кислорода в его средней формуле, т. е. CuO_{0.6}.

^{*} Вероятность взаимодействия с азотом незначительна из-за неустойчивости нитридов меди при температурах выше 300° (6).

Таблица 1 Условия и результаты дериватографических опытов

+0.004

OX- $Cu_2O + \frac{1}{2}O_2 = 2CuO$ $2CuO = Cu_2O + \frac{1}{2}O_2$ MI $Cu_2O_{(KD)} + O_{2(F)} \rightarrow CuO_{X(K)}$ Скорость оз лаждения, град/мин т. окон-чания, °С Скорость грева, град мин экстр., глубина, Навеска, Кривые т. нача-Объект исслепования т. напривес, индекс кисло-рода т. экстр. т. окончаглуби-т. начала, т. экстр., т. окончачала, ния. °С на. % °C ния. °С °C. °C. СиО, прокал. 2595 1.4 998 1030 1060 98.83 1085 1123 1140 60 0.627 СиО, прокал. 2 5065 1,4 3,1 997 1056 1098 97,74 1098 1138 1169 80 0.590 1002 СиО, ч. д. а. 3 4904 0.7 0.7 1006 1057 1078 99,12 1095 1135 90 1150 0.596 1018 СиО, прокал. 4 1,2 1089 3,5 1002 1030 1050 99,68 1087 1121 1140 20,5 0,595 1008 Продукт оп. 3 0,9 4532 2,9 1005 1015 1035 1107 1122 ___ 1130 0,603 1015 Измельч. СиОх 1472 1,8 560 88,9 215 993 1051 1100 88,57 1100 1112 1128 11 0.586 2' Измельч. СиОт 1592 2,1 225 510 71,8 995 1065 1105 89,32 1110 1130 1165 18.5 0,599 3 ' 470 880 99,1 Си₂О, ч.д.а. 1498 2.1 305 998 1054 1072 89,81 1109 1127 1150 13.5 0,591 531 875 93.5 41 1575 245 995 Си2О. синтез. -1.91054 1098 98,28 1098 1131 1162 0.588 Среднее ** 998 + 2 1050 ± 5 1083 + 7 1127 ± 3 1150±5 1098 + 30.597 + 1011 +

ператур. ** Погрешность выражена удвоенной квапратичной ошибкой срепнего результата.

1118

^{*} Глубокий минимум на кривой ДТА отвечает процессу $2Cu_2O_{(Kp)} + CuO_{(Kp)} = Cu_5O_{3(3)}(t_{HAQ} = 1050^\circ; t_{\partial KCTp} = 1070^\circ; t_{KOHeQ} = 1095^\circ)$. Температурные границы процессов в этом опыте несколько искажены из-за малой пористости образца, поэтому не были учтены при расчете средних значений температур.

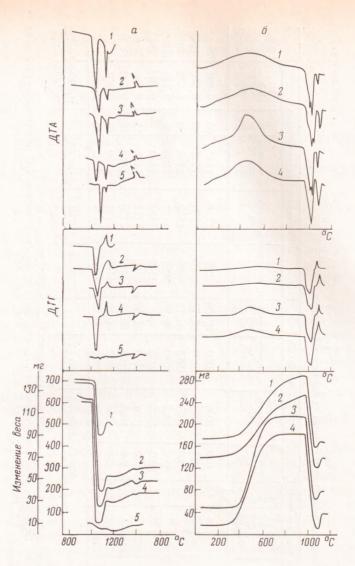


Рис. 1. Дериватограммы исследованных образцов веществ. a:1,2,4 — прокаленная при 900° С, измельчепная CuO; 3 — CuO реактивная, марки ч.д.а.; 5 — продукт опыта 3 без извлечения из тигля. Материал и размеры дериватографических тиглей: 1,3,5 — платина, 22×14 мм; 2 — корунд, 17×12 мм; 4 — платина, 11×8 мм. 6:1 — закаленный в воздухе и измельченный продукт взаимодействия Cu2O с O2 при 1150° ; 2 — закаленный в воде, высушенный под вакуумом при 80° и измельченный продукт взаимодействия Cu2O с O2 при 1150° ; 3 — Cu2O, реактивная, марка ч.д.а.; 4 — Cu2O, синтезированная путем термического разложения CuO при 1050° , закаленная в воде, высушенная под вакуумом при 1050° , закаленная Воде, высушенная под вакуумом при 1050° 0 с и измельченпая. Дериватографический тигель в 1 — илатиновый, 11×8 мм

 $1011\pm6^\circ$. Близость температур кристаллизации $\mathrm{Cu_5O_3}$ и разложения CuO , вероятно, не случайна и обусловлена сравнительно меньшей устойчивостью $\mathrm{Cu_5O_3}$ при температурах около 1000° , что приводит к ее разложению с одновременной кристаллизацией более устойчивых окислов меди — CuO и $\mathrm{Cu_2O}$. Рентгенофазовый анализ подтвердил сделанное предположение: в продуктах взаимодействия $\mathrm{Cu_2O}$ с $\mathrm{O_2}$, синтезированных при $1127\pm7^\circ$ и закаленных в воде или в воздухе, других фаз, кроме CuO и $\mathrm{Cu_2O}$ не было обнаружено.

Поведение измельченных образцов продукта кристаллизации Cu_5O_3 при нагревании в воздухе напоминает поведение чистой закиси меди с несколько меньшей скоростью процесса (рис. 1 б), что можно объяснить затрудненностью доступа кислорода к закиси меди в результате совместной кристаллизации CuO_2 с CuO. Неизмельченный продукт кристаллизации Cu_5O_3 при нагревании до $1050-1070^\circ$ переходит в жидкость, минуя процессы окисления и восстановления окислов меди (рис. 1 a, 5). Это объясняется незначительной пористостью образца.

В условиях неустойчивости CuO выше 1000° полученные результаты трудно интерпретировать образованием эвтектики между окисью и закисью меди. Вероятно, расплав состава Cu_5O_3 является индивидуальным соединением, представляющим собой новую, неизвестную ранее окись

меди.

Поступило 13 II 1973

ШИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ Н. А. Торопов, В. П. Берзаковский и др., Диаграммы состояния силикатных систем, Справочник, ч. 2, Л., 1970. ² М. Т. Мищенко, Строение, механизм образования закиси меди и ее электрические свойства, Львов, 1959. ³ В. П. Жузе, Б. В. Курчатов, ЖЭТФ, 2, № 5—6, 309 (1932). ⁴ Н. Wieder, A. W. Cranderna, J. Phys. Chem., 66, № 5, 816 (1962). ⁵ R. Delhec, Bull. Soc. Roy. Sci., hige, 28, № 9—10, 234 (1959). ⁶ М. П. Славинский, Физико-химические свойства элементов, М., 1955.